



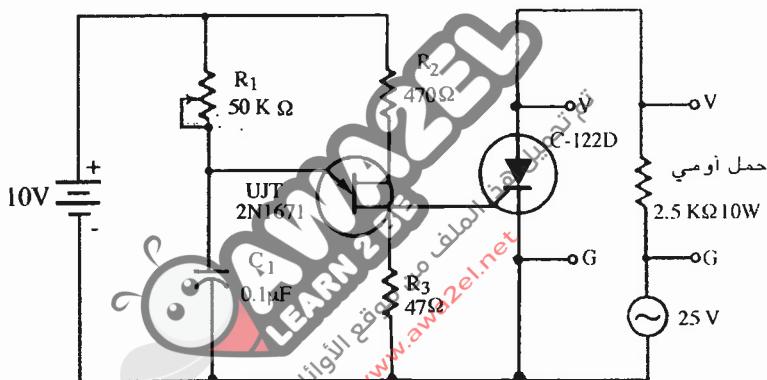
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٥ / الدورة الصيفية

مدة الامتحان : ٣٠ د ٣ س (وثيقة محمية/محظوظ)
اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠١٧/٧/٩ الفرع: الصناعي / المبحث : العلوم الصناعية الخاصة / الإلكترونيات الصناعية / م

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

أ) يبيّن الشكل أدناه دارة قدر غير متزامن باستخدام الترانزستور أحادي الوصلة، أجب عما يأتي: (١٠ علامات)
١- اشرح مبدأ عمل هذه الدارة.
٢- انكر عيوب هذه الدارة.

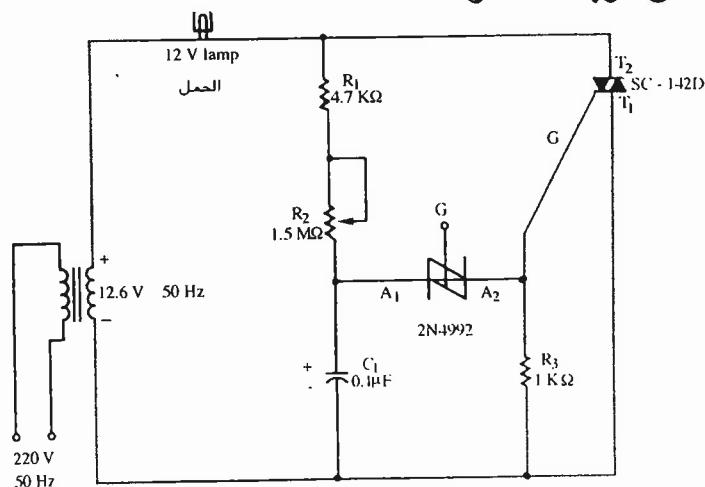


(٥ علامات)

ب) ارسم المكافئ الثنائي لـ الترياك.

السؤال الثاني: (٢٥ علامة)

أ) في الشكل أدناه دارة قدر الترياك باستخدام المفتاح السيليكوني المزدوج، والمطلوب اشرح مبدأ عمل هذه الدارة في النصف الموجب من موجة المصدر. (٧ علامات)



يتبع الصفحة الثانية/ ،،،

الصفحة الثانية

(١٠ علامات)

(٨ علامات)

ب) اشرح مبدأ عمل دارة المفتاح الترانزستوري البسيط مع الرسم.

ج) حول الأعداد العشرية الآتية إلى أعداد ثنائية:

(311 , 100 , 12 , 6)

السؤال الثالث: (٢٥ علامة)

(٥ علامات)

(٨ علامات)

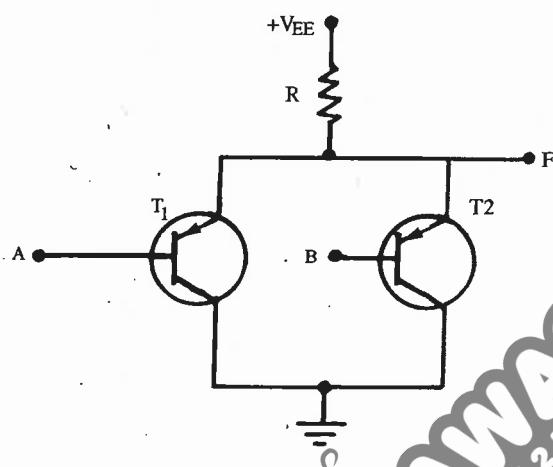
(٦ علامات)

ج) يبيّن الشكل جانباً دارة كهربائية لأحدى البوابات المنطقية، أجب عما يأتي:

١- ما اسم البوابة المنطقية التي تمثلها الدارة؟

٢- ارسم رمز هذه البوابة.

٣- اكتب جدول الصواب لها.



د) باستخدام البوابات المنطقية يمكن بناء النطاط (S-R) (٦ علامات). مطريقتين، اذكرهما مع الرسم.

السؤال الرابع: (٢٥ علامة)

(٤ علامات)

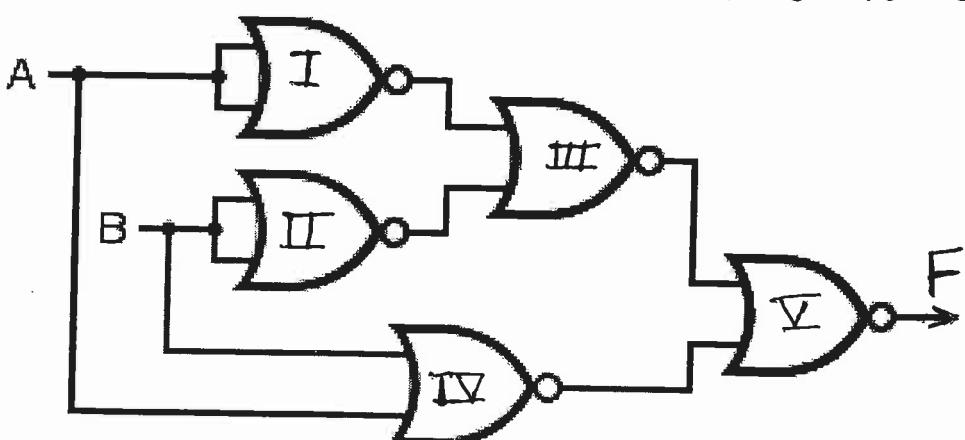
(٦ علامات)

(٦ علامات)

أ) اذكر أربع مميزات للمفاتيح الترانزستورية على نظيراتها الميكانيكية.

ب) تصنف البوابات المنطقية إلى عائلات مختلفة، اذكرها.

ج) اكتب جدول الصواب للدارة المبيّنة أدناه:



(٦ علامات)

(٣ علامات)

د) ارسم رمز النطاط D واتكتب جدول الصواب له.

ه)وضح بماذا يختلف الترياك عن التايرستور.



المبحث : علوم صناعية / الالكترونيات الصناعية ٣
الفرع : الصناعي

مدة الامتحان : ٣ ساعي
التاريخ : ٢٠١٧ / ٦ / ٩

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

السؤال الأول (١٥ درجة)

١ - عند تغيير قيمة المقاومة R_1 يتم تحديد

قيمة الزمن اللازم لشحن الموسوع، ومن ثم معدل توليد نبضات القدح، وعندما تتجاوز الفولطية على طرف الموسوع فولطية القمة للترانزستور V_p يدخل الترانزستور حالة التوصيل (On-State) مما يسمح بتغريغ شحنة الموسوع خلال الترانزستور. ويفعل تيار تغريغ الموسوع C_1 عبر وصلة الباعث- القاعدة $E-B_1$ والمقاومة R_3 . تظهر على المقاومة R_3 فولطية ذات شكل نبضي تعمل على قدح الثايرستور. بواسطة هذه الدارة يمكن قدح الثايرستور بزاوية إزاحة ذات قيمة محددة ويطلق عليها زاوية التأخير (Delay Angle) أو زاوية القدح (Triggering Angle) ويكون التحكم بهذه الزاوية بحيث تتراوح قيمتها بين الصفر و ١٨٠ درجة، مع ملاحظة أن تكون لحظة تطبيق نسبة القدح واقعة خلال النصف الموجب من موجة التغذية الجسيمة.

٢ - ويعيب هذه الدارة عدم وجود توافق بين نبضات قدح الثايرستور وفoltage التغذية المتداوب، حيث تغذى

دارة قدح الترانزستور من مصدر

تيار مستمر DC مستقل تماماً عن

مصدر تغذية الثايرستور ذي التيار

المتداوب، مما يجعل تحقيق التوافق

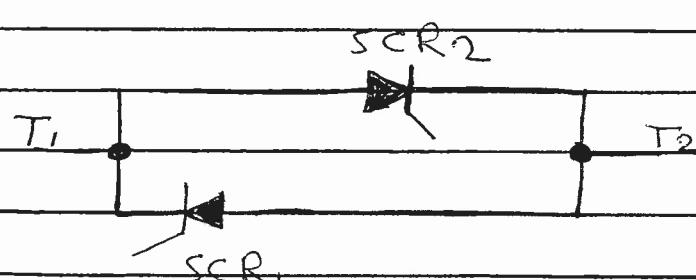
ال زمني بين الدارتين أمراً صعب

ال الحال

السؤال الثاني

الصيغة المدنية

(١٠ درجات)



(٥ درجات)

٢٤

الحوالات المالية (٢٠٢٣)

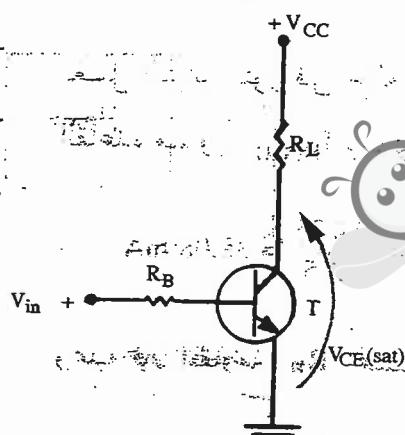
$\vdash \text{def}^{\text{true}} (\rho)$

ففي النصف الموجب من موجهة فولطية المصادر يتم شحن التواسع C إلى الحد الذي تصل فيه الفولطية على طريقة إلى قيمة $\frac{1}{2}C_0$ ، لفولطية العدج الخاصة بالفتح الشيليكوني المردوج، حيث تبدأ لحظتها عملية تفريغ المواسع. وتحدث عملية التفريغ بسرعة كبيرة بحيث يكون تيار التفريغ على شكل نصف موجة تعمل على قدر التردد ω خلال التصف الموجب لفولطية المصدر، ليبدأ بالتوسيع ويستمر كذلك إلى أن يتوقف عن ذلك، حيث يتم هذا الأمر فقط عندما تصل قيمة تيار الحمل للثانية إلى الصفر تقريرياً.

(ملک)

6

عند تطبيق فولطية التدخل V_{in} يسري تيار في دارة القاعدة للترانزستور يعتمد في قيمته على فولطية الدخل V_{in} والمقاومة R_B . عندما يكون هذا التيار أكبر من تيار التشبع للترانزستور تنخفض فولطية مجمعة الترانزستور إلى قيمة صغيرة جداً (0.2 فولط تقريباً)، وتكون فولطية المصدر مطبقة بكاملها تقريباً على دارة الحمل. وفي هذه الحالة تكون الحمل مربوطاً عبر المفتاح الترانزستوري إلى المصدر فيضيء إذا كان مصباحاً ويدور إذا كان محركاً.



عند انخفاض فولطية الدخل إلى الحد الذي لا يسمح بمرور تيار يقابله الترانزستور ($I_B = 0$) يتحول الترانزستور إلى حالة القطع وترتفع فولطية مجموعه لتصبح متساوية فولطية المصدر تقريباً. ويترتب على ذلك انخفاض فولطية الخطا إلى الصفر مما يؤدي إلى إطفائه إذا كان مصباحاً

لایکرات اسٹریچ + ۳ ملی ارسی سی علی (۱۰۰۰ نمونه)

$$11\sigma = \epsilon \quad (2)$$

$$1100 = 12$$

$$1100100 = 100$$

$$100110111 = 311$$

نحو فرعی عدد فتای $\times 3 = 8$ عددها

السؤال الثالث (٢٥ نقطة)

١ - دارة الفتح الخاصه لعنصر التاييرستور (٥)

5

٢ - المزدبات

٣ - حول من المتر

٤ - دارات التوقيت

٥ - وحدات التفريغ متوجه التيار والقولطيه
(٥ درجات)

٦) ١ - صعوبه في استخدام التراكم خاصه في الحال

الكتبه

٢ - ماسيه بواليه التراكم اقل بكثير من طرق

41

حاله التاييرستور

٣ - زعن عطفاء لـ ~~التراكم~~ كمالي عنصري للتاييرستور٤ - اعتبار الاستخدام على المكثفات ~~مكثفه~~ تسيي
نفراً الى قلة تحمل التراكم لعمل التغير في

قولطيه مقارنه بالتايرستور

٥ - قلة الامتحاريه مقارنه بالتييرستور له

يدركه ٣ × ٣ = ٩ درجات

مدتار

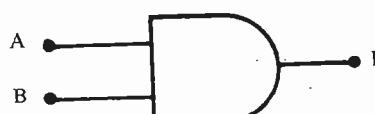
١ - " و (AND) (2)

54

مدتار

مدتار

(٦ درجات)



= ٣

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

= ٣

جدول " و " الصواب

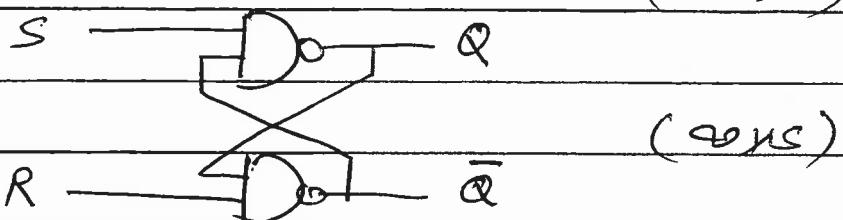
تابع لـ روايات

٥) عن بناء المطاط (S-R) باطرافتين

٦) المطاط (S-R) لـ أبيه بوايتن "أ/ أو" عن

٨١

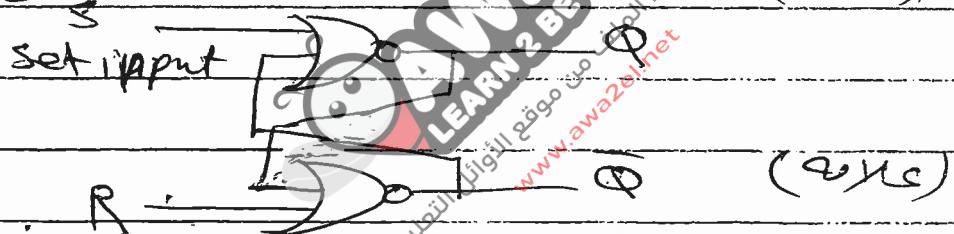
طريق الرحلة المتأخر أو المخطى لما بين الرسم (عزمكاث)



٧) المطاط (S-R) بوايتن "أ/ أو"

٩٣

مع طريق الرحلة المتأخر أو المخطى لما بين الرسم (عزمكاث)



RESET INPUT
إعادة إدخال

المجموع (عزمكاث)

السؤال الرابع (٢٥ مارس)

٥١

(P)

- عدم احتوايتها على أجزاء ميكانيكية متحركة، لذلك فهي أقل عرضة للأعطال والتآكل، ولا تحتاج إلى صيانة تذكر.
 - سرعة توصيلها وفصلها عالية جداً مقارنة مع المفاتيح الميكانيكية، بينما تفاصس سرعة المفتاح الترانزستوري بأجزاء الميكروثانية، ويمكن أن تصل إلى بعض ميكروثانية، تصل سرعة الفصل والوصل في المفاتيح الميكانيكية إلى بعض ميلي ثانية.
 - تم عملية الوصل والفصل في المفاتيح الترانزستورية بشكل فوري دون ارتباك (No Bounce) خاصة عند عملية الوصل وذلك عكس ما هو عليه الحال في المفاتيح الميكانيكية.
 - تم عملية الفصل دون حدوث الشرارة الكهربائية التي تعانقها المفاتيح الميكانيكية وتؤدي عادة إلى تلف ملامسات هذه المفاتيح.
- وعلى الرغم من هذه المزايا وغيرها، فإن هبوط فولطية المفاتيح الترانزستورية (V_{CE}) يجعل إمكانية ربط المفاتيح الترانزستورية على التوالي أمرًا غير ممكناً.

٤١٤ (٤ مارس)

(B)

- 68
- | | |
|------|--|
| RTL | عائلة منطق مترانزستور |
| DTL | عائلة منطق ثنائية - ترانزستور |
| TTL | عائلة منطق ترانزستور - ترانزستور |
| CMOS | عائلة أكيد المعدن شبكة المضام (TTL = ٣x١,٥ تيراهرات) |

(Q)

جدول الضوابط للدارج

٧٩

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

كل حالة معلومة
 $X = 7$ حالات

تابع السؤال الرابع

(٥)

83

Data

P's

D Q

النافذ

clock

CLK \bar{Q}

CLR

عن النهاية

مقدرات

84

Q_{n+1}

O

I

(٣ + ٣) مقدرات

(٦)

يختلف ، لتأثره هنا التيار ستور

- يمكن لهذا العنصر التوصيل عندما تكون فولطية الطرف (T_1) ذات قطبية موجبة أو سالبة، أما الثايرستور فلا يوصل التيار إلا إذا كانت فولطية طرف المصعد (A) ذات قطبية موجبة فقط.
- يمكن لهذا العنصر التوصيل في الاتجاهين، ويتحقق ذلك بتطبيق فولطية بوابة مناسبة، قد تكون ذات قطبية موجبة أو سالبة بالنسبة إلى الطرف (T_1) ، أما الثايرستور فيوصل التيار عندما تكون فولطية البوابة موجبة بالنسبة لطرف المهبط (K).

(٣ مقدرات)